

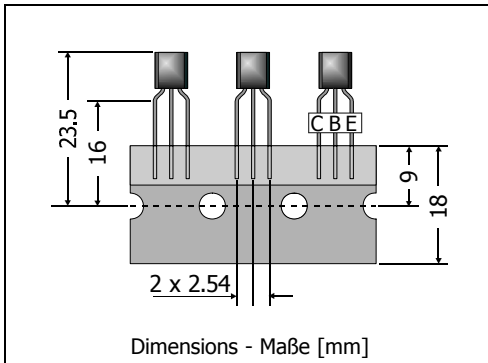
BC327 / BC328

PNP

General Purpose Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz

PNP

Version 2006-05-30


 Power dissipation
 Verlustleistung

625 mW

 Plastic case
 Kunststoffgehäuse
TO-92
(10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

 Plastic material has UL classification 94V-0
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging taped in ammo pack
 Standard Lieferform getupet in Ammo-Pack
Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

			BC327	BC328
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	- V_{CES}	50 V	30 V
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V_{CEO}	45 V	25 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V_{EBO}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- I_C	800 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I_{CM}	1 A	
Base current – Basisstrom		- I_B	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-55...+150°C	

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²⁾					
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 100\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	100	160	250
	Group -25	h_{FE}	160	250	400
	Group -40	h_{FE}	250	400	630
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 300\text{ mA}$	Group -16	h_{FE}	60	130	–
	Group -25	h_{FE}	100	200	–
	Group -40	h_{FE}	170	320	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ²⁾					
- $I_C = 500\text{ mA}$, - $I_B = 50\text{ mA}$		- V_{CEsat}	–	–	0.7 V

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

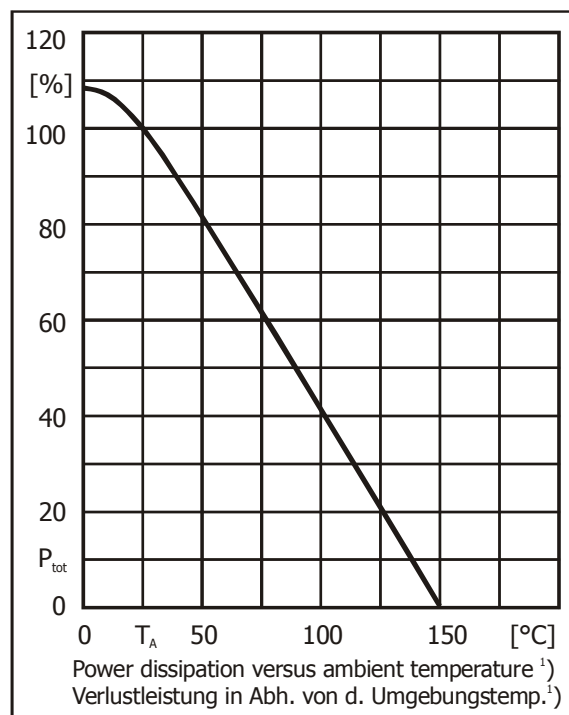
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

2 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

 Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ²⁾				
- $V_{CE} = 1\text{ V}$, - $I_C = 300\text{ mA}$,	- V_{BE}	-	-	1.2 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom				
- $V_{CE} = 45\text{ V}$, (B-E short)	BC327	-	2 nA	100 nA
- $V_{CE} = 25\text{ V}$, (B-E short)	BC328	-	2 nA	100 nA
- $V_{CE} = 45\text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$, (B-E short)	BC327	-	-	10 μA
- $V_{CE} = 25\text{ V}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$, (B-E short)	BC328	-	-	10 μA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 50\text{ MHz}$	f_T	-	100 MHz	-
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = I_E = 0$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{CBO}	-	12 pF	-
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}	< 200 K/W ¹⁾		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		BC337 / BC338		
Available current gain groups per type Lieferbare Stromverstärkungsgruppen pro Typ		BC327-16 BC327-25 BC327-40	BC328-16 BC328-25 BC328-40	



²⁾ Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden